2016

УДК 538.945

# ТРИПЛЕТНЫЙ ЭФФЕКТ И КРИТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ В МНОГОСЛОЙНЫХ СТРУКТУРАХ СВЕРХПРОВОДНИК/ФЕРРОМАГНЕТИК

## В.Н. КУШНИР

#### Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники П. Бровки, 6, Минск, 220013, Беларусь

Поступила в редакцию 2 декабря 2015

Построено точное матричное решение линеаризованных уравнений диффузионного предела микроскопической теории сверхпроводимости, описывающих критическое состояние многослойных структур сверхпроводник/ферромагнетик при неколлинеарных, компланарных векторах намагниченности ферромагнитных слоев.

*Ключевые слова:* сверхпроводимость, ферромагнетизм, слоистые структуры, уравнения Узаделя, критическое состояние.

## Введение

Слоистые структуры сверхпроводник (S)/ферромагнетик (F) являются естественной элементной базой сверхпроводниковой спинтроники, поскольку между S и F системами существует взаимодействие посредством спиновых степеней свободы [1-5]. Управление спиновыми степенями свободы достигается изменением магнитного состояния структуры, что изменяет характеристики ее сверхпроводящего состояния. Если магнитное состояние неоднородно, в структуре индуцируется компонента сверхпроводящего конденсата из триплетных пар электронов с нулевым орбитальным моментом и проекцией полного спина ±1 (помимо существующих триплетных пар с нулевой проекцией спина) [3]. Триплетная сверхпроводимость детально исследована для двухслойных и трехслойных структур, F1/S/F2 и S/F1/F2, в диффузионном и в чистом пределе микроскопической теории сверхпроводимости на основе как точных, так и приближенных методов [1–12], и недавно обнаружена на эксперименте [4, 5]. Однако использование триплетного эффекта в устройствах спинтроники на основе трехслойных структур сопряжено со сложными технологическими проблемами – заметный эффект наблюдается в узком диапазоне толщин слоев, что требует очень высокого качества S-F контактов, надежного контроля материальных параметров системы. Названные проблемы нивелируются для многослойных S/F структур, благодаря «спектральным» свойствам их сверхпроводящего состояния [6, 9, 13-19]. Для исследования критического состояния сверхпроводимости многослойных S/F структур ранее был развит точный матричный метод, применимый при условии коллинеарности векторов намагниченности F-слоев [19, 20]. В данной работе в диффузионном пределе микроскопической теории сверхпроводимости построено точное матричное решение уравнений критического состояния S/F структур с неколлинеарными векторами намагниченности, компланарными поверхностям слоев.

#### Постановка задачи

Координатную плоскость *YOZ* совмещаем с плоскостью подложки *S/F* структуры. Вектор обменного поля *F*-слоев,  $\mathbf{h}(x) = E_{ex} \cdot \mathbf{m}(x)$  [2], где  $\mathbf{m}(x)$  – единичный вектор, сонаправленный вектору намагниченности, а  $E_{ex}$  – обменная энергия, выбираем в виде (0,  $E_{ex} \cdot \sin\theta(x)$ ,  $E_{ex} \cdot \cos\theta(x)$ ). Полагаем, что угол  $\theta(x)$ , задающий направление магнитного момента, фиксирован в каждом

18

*F*-слое. Сверхпроводящее состояние в диффузионном пределе микроскопической теории сверхпроводимости описывается узаделевской аномальной функцией Грина [21], которую можно записать в матричной форме [1–3]:

$$\mathcal{F}_{\omega}(\mathbf{r}) = \left(F_{0,\omega}\sigma_0 + F_{12,\omega}\sigma_2 + F_{13,\omega}\sigma_3\right)\sigma_3 \equiv \left(F_{0,\omega}\sigma_0 + \mathbf{F}_{1,\omega}\sigma\right)\sigma_3.$$
(1)

Здесь  $\sigma_1$ ,  $\sigma_2$ ,  $\sigma_3$  – матрицы Паули,  $\sigma_0$  – единичная 2×2 матрица,  $\omega \equiv \omega_n = \pi k_B T (2n + 1) -$ мацубаровские частоты  $(n = 0, \pm 1, \pm 2,...)$ ;  $F_{0\omega}$  и  $F_{12,\omega}$ ,  $F_{13,\omega}$  – соответственно, синглетная и триплетные составляющие функции  $\mathcal{F}_{\omega}$ , которые выражаются через компоненты аномальной функции Грина в спиновом пространстве следующим образом:  $F_0 = (1/2) (F_{\uparrow\downarrow} - F_{\downarrow\uparrow})$ ,  $F_{13} = (1/2) (F_{\uparrow\downarrow} + F_{\downarrow\uparrow})$ ,  $F_{12} = F_{\downarrow\downarrow} = F_{\uparrow\uparrow}$ .

Функции критического состояния *S/F* структуры удовлетворяют уравнениям [1–3]

$$\begin{cases} \left(-\frac{D_{S}}{2}\partial_{x}^{2}+|\omega|\right)F_{0,\omega}(x)=\Delta(x) \\ , x \in I_{S}, \end{cases}$$

$$\left(-\frac{D_{S}}{2}\partial_{x}^{2}+|\omega|\right)\mathbf{F}_{1,\omega}(x)=\mathbf{0}$$

$$\begin{cases} \left(-\frac{D_{F}}{2}\partial_{x}^{2}+|\omega|\right)F_{0,\omega}(x)+i\operatorname{sgn}(\omega)(\mathbf{h}(x),\mathbf{F}_{1,\omega}(x))=0 \\ , x \in I_{F}, \end{cases}$$

$$\left(-\frac{D_{F}}{2}\partial_{x}^{2}+|\omega|\right)\mathbf{F}_{1,\omega}(x)+i\operatorname{sgn}(\omega)\mathbf{h}(x)F_{0,\omega}(x)=\mathbf{0}$$

$$\Delta(x)=\pi k_{B}T\lambda\sum_{\omega}F_{0,\omega}(x), (x \in I_{S}).$$

$$(2.1)$$

Здесь  $D_S$ ,  $D_F$  – постоянные диффузии электронов в сверхпроводящих и ферромагнитных слоях, соответственно;  $\Delta(x)$  – параметр порядка, равный нулю в *F*-слоях,  $\lambda$  – константа эффективного электрон-электронного взаимодействия;  $I_S$ ,  $I_F$  – области *S* и *F* слоев, соответственно. Легко видеть, что решением систем (2.1)–(2.3) являются частотно-четные функции  $F_{0\omega}$ , и частотно-нечетные функции  $\mathbf{F}_{1,\omega}$ , так что систему переписываем в виде

$$\begin{cases} \left(-\xi_{S}^{2}\partial_{x}^{2}+t(2n+1)\right)F_{0,n}(x)=2t\lambda\sum_{n=0}^{n_{c}}F_{0,n}(x)\\ \left(-\xi_{S}^{2}\partial_{x}^{2}+t(2n+1)\right)F_{1,n}(x)=\mathbf{0}\end{cases} \quad (n=0,1,\dots,n_{c}) \quad x\in I_{S},$$

$$(3.1)$$

$$\begin{cases} \left(-\xi_{F}^{2}\partial_{x}^{2}+t(2n+1)\right)F_{0,n}(x)+2i\frac{\xi_{F}^{2}}{\zeta_{F}^{2}}(\mathbf{m}(x),\mathbf{F}_{1,n}(x))=0\\ \left(-\xi_{F}^{2}\partial_{x}^{2}+t(2n+1)\right)\mathbf{F}_{1,n}(x)+2i\frac{\xi_{F}^{2}}{\zeta_{F}^{2}}\mathbf{m}(x)F_{0,n}(x)=\mathbf{0} \end{cases} \qquad (n=0,1,\dots,n_{c}) \ x\in I_{F} \end{cases}$$
(3.2)

В (3.1), (3.2) использованы обозначения:  $\xi_{S(F)} = \sqrt{\hbar D_{S(F)}} / 2\pi k_B T_S$  – длины когерентности в S(F) слоях, где  $T_S$  – критическая температура массивного сверхпроводника;  $\zeta_F = \sqrt{\hbar D_F / E_{ex}}$  – характерная длина затухания функции состояния в *F* слое;  $t = T/T_S$ ,  $n_c \equiv n_c(T)$  есть целая часть выражения (( $\hbar \omega_c/2\pi k_B T$ ) – 0,5), где  $\omega_c$  – параметр обрезания по мацубаровским частотам.

Системы уравнений (3.1), (3.2) дополняются условиями на границах x = 0 и x = L,

$$\partial_x F_{0,n}(0) = \partial_x F_{0,n}(L) = 0, \ \partial_x \mathbf{F}_{1,n}(0) = \partial_x \mathbf{F}_{1,n}(L) = \mathbf{0},$$
(4)

и условиями сшивания Куприянова – Лукичева на *S*-*F* контактах [22]:  $2^{-1}(x + 0) = 2^{-1}(x - 0) = 2^{-1}(x - 0) = 2^{-1}(x - 0)$ 

$$\rho^{-}(x_{i}+0)\sigma_{x}F_{0,n}(x_{i}+0) = \rho^{-}(x_{i}-0)\sigma_{x}F_{0,n}(x_{i}-0),$$

$$F_{0,n}(x_{i}+0) = F_{0,n}(x_{i}-0) + \frac{\rho_{F}}{\rho(x_{i}-0)}\frac{2\boldsymbol{\ell}_{F}}{3\boldsymbol{t}_{F}}\partial_{x}F_{0,n}(x_{i}-0)$$
(5)

для синглетной составляющей, и точно такими же условиями для триплетных составляющих функции состояния.

В формуле (5) ступенчатая функция  $\rho(x) = \rho_S$ , если  $x \in I_S$  и  $\rho(x) = \rho_F$ , если  $x \in I_F$ , где  $\rho_S$  и  $\rho_F$  – нормальные низкотемпературные удельные сопротивления *S* и *F* слоев, соответственно;  $\ell_F$  – длина свободного пробега электронов в ферромагнитном материале,  $t_F$  – параметр квантовомеханической прозрачности *S*-*F* контакта [23].

В частных случаях  $\theta(x) \equiv 0$  либо  $\theta(x) \equiv \text{const}$ , в уравнениях (3) исчезает триплетная составляющая с проекциями спина ±1 и остается компонента  $(1/2)(F_{\uparrow\downarrow} + F_{\downarrow\uparrow})$  (в случае  $\theta(x) \equiv \text{const}$  ось квантования спина можно направить вдоль **m**). Эта триплетная составляющая сверхпроводящего конденсата в *S/F* структурах всегда существует и проявляется, например, слабыми противотоками, протекающими в ферромагнитных слоях многослойной структуры при включении транспортного тока [19, 20].

# Матричное решение уравнений Узаделя

Граничную задачу (4) для системы ОДУ (3), (5) решаем матричным методом [19, 20], принимая направление вектора намагниченности кусочно-постоянным,  $\mathbf{m}(x) = \mathbf{m}_j$  для *j*-го ферромагнитного слоя. В соответствии со стандартной процедурой, образуем из функций  $F_{0,n}(x)$ столбцы  $\mathbf{\Phi}_0(x) = (F_{0,0}(x) F_{0,1}(x) \dots F_{0,n_c}(x))^{\text{tr}}$ , и из функций  $F_{12,n}(x), F_{13,n}(x)$  – столбцы  $\mathbf{\Phi}_1(x), \mathbf{\Phi}_2(x),$ соответственно. Далее определяем вектор-функцию сверхпроводящего состояния  $\mathbf{Y}(x) = \mathbf{\Phi}_0 \oplus \mathbf{\Phi}_0' \oplus \mathbf{\Phi}_1 \oplus \mathbf{\Phi}_1' \oplus \mathbf{\Phi}_2 \oplus \mathbf{\Phi}_2'$  и записываем формальное решение задачи Коши с начальным условием  $\mathbf{Y}(0) = \mathbf{Y}_0$ 

$$\mathbf{Y}(x) = \boldsymbol{\mathcal{R}}(x) \, \mathbf{Y}_0 \,, \tag{6}$$

где **Я**(*x*) – матрицант (матрица канонической системы фундаментальных решений) [24].

Подстановка в (6) граничных условий приводит к однородной системе 3×(n<sub>c</sub>+1) линейных алгебраических уравнений

$$\mathcal{R}_{246,135}(L) \, \Phi(0) = \mathbf{0}, \tag{7}$$

где матрица  $\mathcal{R}_{246,135}(x)$  получена из  $\mathcal{R}(x)$  вычеркиванием строк, соответствующих функциям  $\Phi_0(x)$ ,  $\Phi_1(x)$ ,  $\Phi_2(x)$ , и вычеркиванием столбцов, соответствующих их производным.

Из условия существования нетривиального решения (7) следует характеристическое уравнение

$$\det[\mathcal{R}_{246,135}(L)] = 0. \tag{8}$$

Его корнями являются собственные критические температуры, которым соответствуют собственные вектор-функции состояний, полученные в результате решения системы (7).

Матрицант  $\Re(x)$  вычисляем, пользуясь рекуррентными соотношениями

$$\mathcal{R}(x) = \mathfrak{S}(x - x_i) \,\mathfrak{P}_{SF} \,\mathcal{R}(x_i) = \mathfrak{S}(x - x_i) \,\mathfrak{P}_{SF} \,\mathfrak{M}^{\alpha}(x - x_{i-1}) \,\mathfrak{P}_{FS} \,\mathcal{R}(x_{i-1}) = \dots,$$
(9.1)

если *х* принадлежит *S*-слою с левой граничной плоскостью  $x = x_i$ , и

$$\mathcal{R}(x) = \mathfrak{M}^{\alpha}(x - x_j) \,\mathfrak{P}_{FS} \,\mathcal{R}(x_j) = \mathfrak{M}^{\alpha}(x - x_j) \,\mathfrak{P}_{FS} \,\mathfrak{S}(x - x_{j-1}) \,\mathfrak{P}_{SF} \,\mathcal{R}(x_{j-1}) = \dots,$$
(9.2)

если *х* принадлежит *F*-слою с левой граничной плоскостью  $x = x_j$ .

В (9.1), (9.2)  $\mathfrak{S}(x)$ ,  $\mathfrak{M}^{\alpha}(x)$  – матрицанты системы ОДУ (3.1) и (3.2), соответственно, и  $\mathfrak{P}_{FS}$ ,  $\mathfrak{P}_{SF}$  – матрицы условий на *S*-*F* контакте.

#### Матрицанты слоев и матрицы контактных условий

В соответствии с (3.1), матрицант *S*-слоя имеет следующую форму:

$$\mathfrak{S}(x) = \begin{pmatrix} S^{+}(x) & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & S^{-}(x) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & S^{-}(x) \end{pmatrix},$$
(10)

где  $S^+(x)$ ,  $S^-(x)$  определены в [20], (гл. 2).

Точно так же матрица условий на S-F контакте

 $\mathfrak{P}_{FS(SF)} = \begin{pmatrix} \mathscr{P}_{FS(SF)} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathscr{P}_{FS(SF)} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathscr{P}_{FS(SF)} \end{pmatrix}$ 

есть результат добавления третьего диагонального блока  $\mathscr{P}_{FS(SF)}$  в матрицу  $\mathfrak{P}_{FS(SF)}$ , приведенную в [20] (матрица  $\mathfrak{P}_{SF(FS)}$  отображает решение  $\mathbf{Y}(z)$  из F(S)-слоя в S(F)-слой).

Выполним в (3.2) замену переменных (преобразование вращения)

$$\Psi_{1,n} = F_{13,n} \cos\theta + F_{12,n} \sin\theta$$

$$\Psi_{2,n} = -F_{13,n} \sin\theta + F_{12,n} \cos\theta$$
Torga система (3.2) преобразуется к виду
$$\begin{cases} \left(-\xi_F^2 \partial_x^2 + t(2n+1)\right) \Phi_{0,n}(x) + 2i(\xi_F / \zeta_F)^2 \Psi_{1,n}(x) = 0 \\ \left(-\xi_F^2 \partial_x^2 + t(2n+1)\right) \Psi_{1,n}(x) + 2i(\xi_F / \zeta_F)^2 \Phi_{0,n}(x) = 0 \quad (n = 0, 1, ..., n_c) \quad x \in I_F. \end{cases}$$
(12)

независимого от нее третьего уравнения. Матрицант подсистемы, включающей первые два уравнения, приведен в [20]; в результате полный матрицант системы (13) записывается в виде

$$\mathfrak{M}(x) = \begin{pmatrix} \operatorname{Re}(\mathcal{M}(x)) & i \operatorname{Im}(\mathcal{M}(x)) & \mathbf{0} \\ i \operatorname{Im}(\mathcal{M}(x)) & \operatorname{Re}(\mathcal{M}(x)) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathcal{N}(x) \end{pmatrix}.$$
(14)

Здесь  $\mathcal{M}(x)$ ,  $\mathcal{N}(x) - 2(n_c+1) \times 2(n_c+1)$ -размерные матрицы-функции, из них  $\mathcal{M}(x)$  определена в [20], а  $\mathcal{N}(x)$  имеет вид

$$\mathcal{N}(x) = \begin{pmatrix} \operatorname{diag} \operatorname{ch} \left( \frac{x \sqrt{t(2n+1)}}{\xi_F} \right) \end{bmatrix} & \operatorname{diag} \left[ \frac{\xi_F}{\sqrt{t(2n+1)}} \operatorname{sh} \left( \frac{x \sqrt{t(2n+1)}}{\xi_F} \right) \right] \\ \operatorname{diag} \left[ \frac{\sqrt{t(2n+1)}}{\xi_F} \operatorname{sh} \left( \frac{x \sqrt{t(2n+1)}}{\xi_F} \right) \right] & \operatorname{diag} \left[ \operatorname{ch} \left( \frac{x \sqrt{t(2n+1)}}{\xi_F} \right) \right] \end{pmatrix},$$
(15)

где diag $[a_n]$  – диагональная матрица с элементами  $a_n$  ( $n = 0, 1, ..., n_c$ ) вдоль главной диагонали.

Таким образом, для каждого *j*-го *F*-слоя имеем матрицант,  $\mathfrak{M}(x - x_j)$ , системы уравнений (13), не зависящий от угла  $\theta$ . По найденной матрице  $\mathfrak{M}(x - x_j)$  легко получить решение задачи Коши,  $\mathbf{Y}(x_j) = \mathbf{Y}_j$ , для исходной системы уравнений (3.2), описывающей сверхпроводящее состояние *j*-го *F*-слоя. Для этого вначале преобразуем, в соответствии с (12), вектор  $\mathbf{Y}_j$  в начальный вектор,  $\mathbf{Y}_j^{\theta} = \mathbf{\Phi}_0 \oplus \mathbf{\Phi}_0' \oplus \mathbf{\Psi}_1 \oplus \mathbf{\Psi}_1' \oplus \mathbf{\Psi}_2 \oplus \mathbf{\Psi}_2'$ , для системы (13):

$$\mathbf{Y}_{j}^{\theta} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} \cdot \cos \theta_{j} & \mathbf{1} \cdot \sin \theta_{j} \\ \mathbf{0} & -\mathbf{1} \cdot \sin \theta_{j} & \mathbf{1} \cdot \cos \theta_{j} \end{pmatrix} \mathbf{Y}_{j} \equiv \boldsymbol{\mathcal{U}}(\theta_{j}) \mathbf{Y}_{j},$$
(16)

(11)

где **1** – единичная матрица размерности  $2(n_c+1)$ .

Далее по начальному вектору  $\mathbf{Y}_{i}^{\theta}$  находим решение  $\mathbf{Y}^{\theta}(x)$  системы (13) в области *j*-го *F*-слоя,  $I_{F,i}$ ,  $\mathbf{Y}^{\theta}(x) = \mathfrak{M}(x - x_i)\mathbf{Y}_i^{\theta}$ , и, совершая обратное вращение, имеем искомый вектор

$$\mathbf{Y}(x) = \mathcal{U}(-\theta_j) \ \mathfrak{M}(x - x_j) \mathcal{U}(\theta_j) \mathbf{Y}_j \ (x \in I_{F,j}).$$
(17)

Из (17) следует выражение для матрицанта *F*-слоя,  $\mathfrak{M}_i^{\theta}(x)$ ,

$$\mathfrak{M}_{i}^{\theta}(x) = \mathcal{U}(-\theta_{i})\mathfrak{M}(x-x_{i})\mathcal{U}(\theta_{i}).$$

Таким образом, формулой (18) выражается простой математический смысл триплетного эффекта. Используя (18), запишем выражения для матрицантов элементарных структур, FO/S/F и *S*/*F*0/*F*. В первом случае имеем (19)

(18)

$$\mathcal{R}(x) = \mathfrak{M}(x)\mathfrak{P}_{FS}\mathfrak{S}(x-d_{F0})\mathfrak{P}_{SF}\mathfrak{U}(-\theta)\mathfrak{M}(x-d_{F0}-d_{S})\mathfrak{U}(\theta),$$

где d<sub>F0</sub> и d<sub>S</sub> – толщины слоев F0 и S, соответственно, а во втором, в приближении полностью прозрачной границы между слоями F0 и F, получим  $\mathcal{R}(x) = \mathfrak{S}(x - d_{\mathrm{F0}}) \mathfrak{P}_{SF} \mathfrak{M}(x) \mathcal{U}(-\theta) \mathfrak{M}(x - d_{\mathrm{F0}} - d_{\mathrm{S}}) \mathcal{U}(\theta).$ (20)

#### Численный пример

Рассмотрим 5-бислойную S/F структуру с тонким центральным S-слоем, для которой ранее рассчитывался спин-вентильный эффект [18]. Все S-слои структуры, за исключением центрального, имеют толщину  $d_S \approx 4.7\xi_S$  (примерно 27 нм); для толщин центрального S-слоя и Fслоев примем значение  $d = d_F = \zeta_F = 0.5\xi_S$  (около 3 нм). Рассчитываем критическую температуру при одновременном повороте магнитных моментов четных *F*-слоев на угол  $\theta$  из начального состояния с ферромагнитным упорядочением (каждый F-слой характеризуется магнитным моментом  $\mathbf{M}_0$ ). В конечном состоянии,  $\theta = \pi$ , в структуре устанавливается антиферромагнитный порядок (AF) (магнитные моменты соседних F-слоев,  $M_i = \pm M_0$ , антипараллельны). Рассчитанная зависимость  $T_c(\theta)$  представлена на рис. 1. Кроме того, на рис. 1 приведены характеристики структуры  $T_{c0,F}(d)$ ,  $T_{c1,F}(d)$  и  $T_{c,AF}(d)$  с ферромагнитным и антиферромагнитным упорядочением моментов  $M_i$ . В первом случае при толщине  $d \approx 2,65\xi_s$  происходит кроссовер состояний с симметричной и антисимметричной синглетной составляющей конденсатной волновой функции (им соответствуют критические температуры  $T_{c0,F}$  и  $T_{c1,F}$ ). Следовательно, при вращении магнитных моментов структура переходит из π-состояния с ферромагнитным упорядочением моментов (треугольник на графике  $T_{c1,F}(d)$ ) в 0-состояние с антиферромагнитным порядком (треугольник на графике  $T_{c,AF}(d)$ ). Более подробно этот переход совершается следующим образом (рис. 1). При увеличении угла θ от нуля до значения θ<sup>сг</sup> ≈ 84° синглетная составляющая функции состояния остается антисимметричной, при этом критическая температура убывает. В точке  $\theta^{cr}$  происходит кроссовер – система переходит в состояние с симметричной синглетной составляющей, что отражается резким возрастанием Тс. Для иллюстрации на рис. 2 приведены графики функций состояния, рассчитанные для трех значений угла 0: 0°, 105°, 180°.



Рис. 1. Зависимость критической температуры структуры 5[F/S]/F от угла между магнитными моментами четных и нечетных F-слоев. На вставке: критические температуры ферромагнитного (F) и антиферромагнитного (AF) состояний структуры в зависимости от толщины центрального S-слоя



Рис. 2. Функции критического состояния структуры 5[F/S]/F для трех значений угла между магнитными моментами четных и нечетных *F*-слоев:  $\theta = 0^{\circ}(a), \theta = 105^{\circ}(b), \theta = 180^{\circ}(b)$ 

#### Заключение

В данной работе впервые построено точное матричное решение линеаризованных уравнений Узаделя, позволяющее анализировать критическое состояние многослойных структур сверхпроводник/ферромагнетик при неколлинеарных, компланарных векторах намагниченности, и без ограничения на количество бислоев.

# TRIPLET EFFECT AND THE SUPERCONDUCTIVITY STATES IN THE MULTILAYERED SUPERCONDUCTOR/FERROMAGNET STRUCTURES

# V.N. KUSHNIR

#### Abstract

The precise matrix solution of the linearized Usadel equations for the multilayered Superconductor/Ferromagnet structures has given for arbitrary in-plane magnetization vectors of ferromagnet layers and an arbitrary layer number.

*Keywords*: superconductivity, ferromagnetism, multilayered structures, Usadel equations, critical condition.

# Список литературы

- 1. Golubov A.A., Kupriyanov M.Yu., Il'ichev E. // Rev. Mod. Phys. 2004. Vol. 76. P. 411–469.
- 2. Buzdin A. I. // Rev. Mod. Phys. 2005. Vol. 77. P. 935–976.
- 3. Bergeret F.S., Volkov A.F., Efetov K.B. // Rev. Mod. Phys. 2005. Vol. 77. P. 1321–1373.
- 4. Кушнир В.Н., Прищепа С.Л. // Вестник Фонда фундаментальных исследований. 2011. № 1/11. С. 101–120.
- 5. Кушнир В.Н., Прищепа С.Л. // Вестник Фонда фундаментальных исследований. 2015. № 2/15. С. 165–192.
- 6. Bergeret F.S., Volkov A.F., Efetov K.B. // Phys. Rev. B 2003. Vol. 68, № 6. P. 064513 (1-14).
- 7. Fominov Ya.V., Golubov A.A., Kupriyanov M.Yu. // Письма в ЖЭТФ. 2003. Т. 77, № 9. С. 609–614.
- 8. *Eschrig M., Kopu J., Konstandin A. et al.* // Advances in Solid State Physics (book series). Vol. 44. / Ed. B. Kramer. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2004. P. 533–546.
- 9. Löfwander T., Champel T., Durst J. Eschrig M. // Phys. Rev. Lett. 2005. Vol. 95. P. 187003 (1-4).
- 10. Halterman K., Barsic P.H., Valls O.T. // Phys. Rev. Lett. 2007. Vol. 99. P. 127002 (1-4).
- 11. Fominov Ya.V., Golubov A.A., Karminskaya T.Yu. et al. // Письма в ЖЭТФ. 2010. Т. 91, № 6. С. 329–333.
- 12. Wu C.-T., Valls O.T., Halterman K. // Phys. Rev. B. 2012. Vol. 86. P. 014523 (1-13).
- 13. Карминская Т.Ю., Куприянов М.Ю., Голубов А.А. // Письма в ЖЭТФ. 2008. Т. 87, № 10. С. 657–663.
- 14. Karminskaya T.Yu., Golubov A.A., Kupriyanov M.Yu. // Phys. Rev. B. 2011. Vol. 84. P. 064531 (1-5).
- 15. Proshin Yu.N., Izyumov Yu.A., Khusainov M.G. // Phys. Rev. B. 2001. Vol. 64. P. 064522 (1-5).
- 16. Proshin Yu.N., Zimin A., Fazleev N.G. et al. // Phys. Rev. B. 2006. Vol. 73. P. 184514 (1-12).
- 17. Karminskaya Т.Ү., Kupriyanov М.Ү. // Письма в ЖЭТФ. 2008. Т. 86, № 1. С. 65–70.
- 18. Кушнир В.Н. // Докл. БГУИР. 2013. № 8 (78). С. 40-47.
- 19. Кушнир В.Н., Куприянов М.Ю. // Письма в ЖЭТФ. 2011. Т. 93, № 9. С. 597-602.
- 20. Кушнир В.Н. Сверхпроводимость слоистых структур. Минск, 2010.
- 21. Usadel K. // Phys. Rev. Lett. 1970. Vol. 25.P. 507-509.
- 22. Куприянов М.Ю., Лукичев В.Ф. // ЖЭТФ. 1988. Т. 94, № 6. С. 139–149.
- 23. Tagirov L.R. // Physica C. 1998. Vol. 307. P. 145–163.
- 24. Якубович В.А., Старжинский В.М. Линейные дифференциальные уравнения с периодическими коэффициентами и их приложения. М., 1972.